

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 01287965  
PUBLICATION DATE : 20-11-89

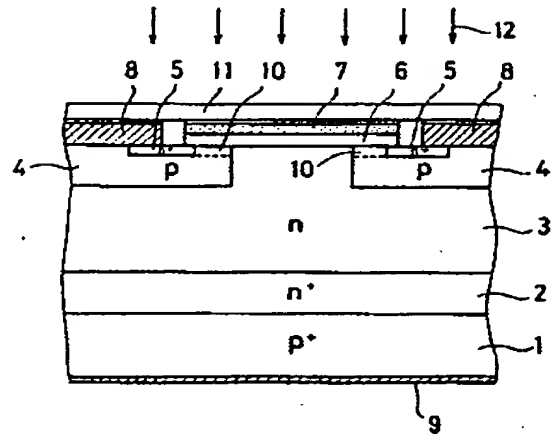
APPLICATION DATE : 13-05-88  
APPLICATION NUMBER : 63117385

APPLICANT : MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

INVENTOR : HAGINO HIROYASU;

INT.CL. : H01L 29/78 H01L 21/322 H01L 29/68

TITLE : MANUFACTURE OF  
SEMICONDUCTOR DEVICE



ABSTRACT : PURPOSE: To suppress a decrease in a threshold voltage value within an allowable range, and to perform a high speed operation by manufacturing an insulated gate type transistor on a semiconductor substrate, and irradiating a coating material covering the surface of the transistor with an electron beam.

CONSTITUTION: A source electrode 8 made of metal such as aluminium or the like for electrically connecting an n-type source region 5 to a p-type base region 4 is formed, and a drain electrode 9 ohmically connected to a p+ type drain layer 1 is formed.

The surface of an IGBT (conductivity modulation element) wafer formed in this manner is covered with a thin film 11 having approx. 100μm of thickness, and the film 11 is irradiated with an electron beam 12 to damage an n-type body layer 3, thereby shortening the life time of holes. Thus, a variation in the threshold value voltage based on the irradiation with the electron beam is suppressed in an allowable range, and an insulated gate transistor having short turning OFF time can be manufactured.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

③ 日本国特許庁(JP)

④ 特許出願公開

## ⑤ 公開特許公報(A) 平1-287965

⑥ Int. Cl.<sup>4</sup>H 01 L 29/78  
21/322  
29/58

識別記号

3 2 1

庁内整理番号

J-8422-5F  
L-7738-5F  
8528-5F

⑦ 公開 平成1年(1989)11月20日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

⑧ 発明の名称 半導体装置の製造方法

⑨ 特 願 昭63-117385

⑩ 出 願 昭63(1988)5月13日

⑪ 発 明 者 萩 野 浩 靖 兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹  
製作所内

⑫ 出 願 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

⑬ 代 理 人 弁理士 大 岩 増 雄 外2名

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

半導体装置の製造方法

## 2. 特許請求の範囲

(1) 半導体基板を準備する第1工程と、

前記半導体基板上に絶縁ゲート型トランジスタを製造する第2工程と、

前記第2工程で製造された前記トランジスタの表面上を被覆物で覆う第3工程と、

前記トランジスタの被覆被覆物上より電子線を照射する第4工程とを含む半導体装置の製造方法。

## 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は絶縁ゲート型トランジスタのターンオフ時間短縮を図った半導体装置の製造方法に関するものである。

(従来技術)

第4図は従来のnチャネル型電圧増幅形の双極性電流源予備IGBT(Isolated Gate Bipolar Transistor)を示す断面図である。

図面において、1はp<sup>+</sup>半導体基板から成るp<sup>+</sup>ドレイン層であり、その一方主面上にはキャリアを制御するためのn<sup>+</sup>バッファ層2が形成されている。このn<sup>+</sup>バッファ層2の表面上にはnボディ層3が形成されている。このnボディ層3の表面の一部領域には、p形不純物をイオン注入あるいは拡散することによりpベース領域4が形成され、さらにこのpベース領域4の表面の一部領域には、高濃度のn形不純物をイオン注入あるいは拡散することによりn<sup>+</sup>ソース領域5が形成されている。nボディ層3の表面とn<sup>+</sup>ソース領域5の表面とで挟まれpベース領域4の表面上にはゲート酸化膜6が形成され、このゲート酸化膜6は開接するIGBTセル間で一体となるようnボディ層3の表面上にも形成されている。ゲート酸化膜6上には例えばポリシリコンから成るゲート電極7が形成され、またpベース領域4およびn<sup>+</sup>ソース領域5の両方に電気的に導通するように例えばアルミなどの金属のソース電極8が形成されている。また、p<sup>+</sup>ドレイン層1の裏面に

は金属のドレイン電極9が全IGBTセルに対し一併に形成されている。

nボディ層3とn<sup>+</sup>ソース領域5とで決まれたロベース領域4の近傍はnチャネルのMOS構造となっており、ゲート電極7が正、ソース電極8が負となるゲート電圧 $V_G$  ( $> V_{th}$  (閾値電圧))を印加することより、ゲート電極7直下のロベース領域4の近傍近傍のチャネル領域10がn型に反転し、このチャネル領域10を通じて、電子がn<sup>+</sup>ソース領域5よりnボディ層3へと流れる。一方、p<sup>+</sup>ドレイン層1からは少数キャリアである正孔がnボディ層3に注入され、その一部は上記電子と再結合して消滅し、残りは正孔電流としてロベース領域3を流れる。この様にIGBTは、基本的にバイポーラ的な動作をし、nボディ層3では、正孔による逆導電率増大の影響により結晶性が悪化することにより、従来のパワーMOSに比べて低いオン電圧、大きい電流密度を実現できる利点がある。

通常のMOSFETでは、500Vを超えるよ

うな高耐圧素子ではnボディ層3のオン抵抗を非常に大きくする必要があるが、IGBTでは逆導電率増大により高耐圧なnボディ層3の近傍近傍を著しく下げることが可能となり、低耐圧でかつオン電圧の低い素子を実現できる。

(発明が解決しようとする課題)

従来のIGBTは以上のように構成されていた。

また、負のゲート電圧( $-V_G$ )を印加することで、IGBTをオフさせることができるが、チャネル領域10の導電率がn-pに戻るまで電子はすぐに消滅するが、p<sup>+</sup>ドレイン層1から注入された正孔は自己消滅する以外にない。従って、正孔のライフタイムが長いとターンオフ時間が長くなり逆導電率増大に反対をきたす問題点があった。

正孔の寿命を短くする方法の一つとして完成したIGBTへの電子線の照射が挙げられる。この電子線の照射によりnボディ層3に熱損を与えることで、正孔のライフタイムを短くできる。

しかしながら、電子線を照射することによりゲート酸化膜にも損傷を与え、さらに照射する電

子線が空気中の酸素と反応しオゾンが大気中に発生する。このオゾン等のイオンがIGBTウエハ表面に吸着することでチャネル領域10がn型に反転しやすくなりIGBTの閾値電圧 $V_{th}$ が変化(低下)してしまう。第1図は電子線の照射量と閾値電圧 $V_{th}$ の変化を示したグラフであるが、同時に示すように、電子線の照射量の増加に伴い、閾値電圧 $V_{th}$ が大きく低下している。

そこで300℃程度の加熱処理(2時間程度)により電子線照射後の閾値電圧 $V_{th}$ の低下及びnボディ層3の損傷を回復(アニール)させている。また、IGBT動作時の温度上昇に伴うアニールにより、動作中における閾値電圧 $V_{th}$ 及びターンオフ時間の変動を防ぐためにも、予め300℃程度の加熱処理によるアニールが必要である。

しかし $V_{th}$ の低下が大きすぎると、 $V_{th}$ の低下を所定範囲内に回復させるために450℃程度の高温での熱処理が必要となり、nボディ層3の損傷をほとんど回復させてしまうことになってしまう。結局正孔のライフタイムは電子線照射後の状

態に戻ってしまうという問題点があった。

この発明は上記のような問題点を解決するためになされたもので、閾値電圧値の低下を所定範囲内に抑え逆導電率増大を可能にした半導体装置の製造方法を提供することを目指すとする。

(課題を解決するための手段)

この発明にかかる半導体装置の製造方法は、半導体基板を準備する第1工程と、前記半導体基板上に絶縁ゲート型トランジスタを製造する第2工程と、前記第2工程で製造された前記トランジスタの表面を被覆物で覆う第3工程と、前記トランジスタの前記被覆物上より電子線を照射する第4工程とを含んでいる。

(作用)

この発明におけるトランジスタへの電子線の照射は、被覆物を介して行われるため、空気中のオゾン等のイオンがトランジスタ表面に吸着することはない。

(実施例)

第1図はこの発明の一実施例であるIGBTの

製造方法説明用の断面図である。

以下、第1図を参照してIGBTの製造方法を示す。まず、ボロン等の不純物を有する比抵抗  $0.01 \Omega \text{cm}$  程度の  $p^+$  ドレイン層1上に、厚さ  $20 \mu\text{m}$ 、比抵抗  $0.08 \Omega \text{cm}$  の  $n^+$  パッパ層2をエピタキシャル成長により形成する。さらに連続的にエピタキシャル成長により約  $50 \Omega \text{cm}$  の高比抵抗の  $n$  ボディ層3を  $100 \mu\text{m}$  程度の厚さで形成する。 $n$  ボディ層3は上記した厚さ、比抵抗で  $1000 \text{V}$  程度の耐圧性がある。

$n$  ボディ層3上全面に厚さ  $1000 \text{\AA}$  程度の酸化膜を形成し、この酸化膜上にポリシリコン層を形成する。これらの酸化膜、ポリシリコン層に対する写真露光によってゲート酸化膜6及びゲート電極7を形成し、このゲート電極7をマスクとしてイオン注入法によりボロンを注入し、 $p$  ベース領域4を形成する。さらに同じくゲート電極7をマスクとしてリン、ヒ素等の不純物を有する  $n$  ソース領域5を拡散又はイオン注入法によって形成する。次に  $n$  ソース領域5と  $p$  ベース領域4を結

晶的に接合したアルミ等の金属よりなるソース電極8を形成し、さらに  $p^+$  ドレイン層にオーミック接触されるドレイン電極9が形成される。

このように形成されたIGBTウエハの断面を約  $100 \mu\text{m}$  程度の薄いフィルム膜11で覆う。このフィルム膜11による保護は、ポリイミドやレジスト等を溶剤にしスピナー等でコーティングすることで絶的に密着させフィルム化することで行われる。そして、第1図で示すようにフィルム膜11上から電子線12を照射することで  $n$  ボディ層3に荷電を与え、正孔のライフタイムを短くする。第2図はフィルム膜11の有無によるIGBTの電子線照射前後と側面電圧変化  $\Delta V_{th}$  の波形を示すグラフである。同図に示すようにフィルム膜11を有するIGBT(図中11で示す)の方が、フィルム膜を有さないIGBT(図中12で示す)より、電子線照射に基づく側面電圧変化  $\Delta V_{th}$  は半分以下程度に抑えられていることがわかる。一例を示すと、厚さ  $1500 \text{\AA}$  のゲート酸化膜を有するIGBTに加速電圧  $1 \text{MeV}$ 、ドーズ

面  $5 \times 10^{14} / \text{cm}^2$  の電子線を照射した場合、フィルム膜11を有したIGBTで  $-10 \text{V}$  程度、フィルム膜を有さなかったIGBTで  $-28 \text{V}$  程度の側面電圧変化  $\Delta V_{th}$  がみられた。

次に、フィルム膜11を取り、側面電圧変化  $\Delta V_{th}$  回復のための熱処理を行う。第3図は、フィルム膜の有無による電子線照射後のIGBTのアニール温度と側面電圧の関係、及びアニール温度とターンオフ時間の関係を示したグラフである。同図に示すように、 $-2$ 、 $-3 \text{V}$  程度の側面電圧変化  $\Delta V_{th}$  を許容範囲とすれば、電子線照射時にフィルム膜11を有したIGBT(図中13で示す)の側面電圧  $V_{th}$  は  $320 \sim 330^\circ \text{C}$  程度で回復する。一方、フィルム膜11を有さなかったIGBT(図中14で示す)は  $360^\circ \text{C}$  以上のアニール温度が必要される。

一方、アニール温度により  $n$  ボディ層3が回復することによるターンオフ時間は電子線照射時のフィルム膜の有無に関係なく同一である(図中15で示す)。従って、電子線照射時にフィルム

膜11を有したIGBTは  $320 \sim 330^\circ \text{C}$  程度の熱処理で側面電圧  $V_{th}$  が回復するためターンオフ時間は  $1 \mu\text{s}$  程度であるのに対して、電子線照射時にフィルム膜11無しIGBTは  $380^\circ \text{C}$  以上の熱処理で側面電圧  $V_{th}$  が回復するため、 $4 \sim 5 \mu\text{s}$  と、電子線照射は効の状態で戻ってしまう。

このように、フィルム膜11を形成したIGBT上より電子線照射することで、オゾン等のイオンがIGBTウエハ表面に吸着するのを確実に防止し、側面電圧変化  $\Delta V_{th}$  を最小限に抑制できる。このため、 $n$  ボディ層3がほぼ完全に回復する以前のアニール温度で側面電圧  $V_{th}$  の熱処理にあげる回復が図れる。従ってターンオフ時間の短縮を實現できる。

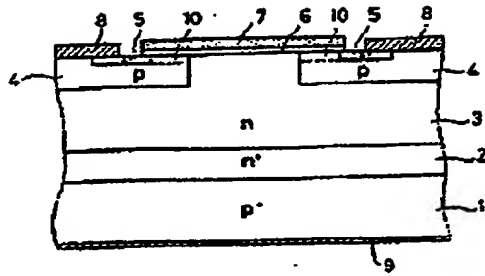
なお、フィルム膜11の形成方法は実施例に示した以外にも紫色紙やポリエチレンで膜をつくり、その袋の中にIGBTウエハを入れても良く、薄膜を表面に密着してもよい。しかしながら、IGBTの製造ラインに電子線装置がイオン注入機のように設置されている場合は、実施例で示した方法

第1図はこの発明の一実施例であるIGBTの製造方法を示すIGBTの断面図、第2図はこの発明により製造されたIGBTにおける電子飽和区画と空乏層圧変化の関係を示すグラフ、第3図

代理人 大 田 船 廠

11-----フィルム腰  
12-----電子線

第 4 圖



第 5 圖

